

Фамилия, имя, отчество	Вагапова Наргиза Тухтамышевна
Должность, ученая степень, ученое звание	Старший преподаватель
Электронная почта	vagapova.nt@misis.ru
Рабочий телефон	+7 499 237-21-2
Область научных интересов	Полупроводниковые приборы, фотоэлектрические преобразователи
Трудовая деятельность	С 04.2013 г. АО «НПП «Квант». С 01.12.2017 – ассистент каф. ППЭ и ФПП НИТУ «МИСиС», с 01.10.2018 – старший преподаватель каф. ППЭ и ФПП НИТУ «МИСиС»
Образование	МИТХТ, степень магистр техники и технологии по направлению «Материаловедение и технология новых материалов» (2007), к.х.н. (2012)
Основные результаты деятельности	В 2017 г. в соответствии с распоряжением Президента является стипендиатом стипендий работникам оборонно-промышленного комплекса за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства
Значимые проекты, гранты	НИР и ОКР в рамках ГОЗ Учебно-методическая литература Лебедев А.А., Вагапова Н.Т., Наумова А.А., Смирнов А.А. Технология и оборудование для производства наногетероструктурных солнечных элементов: лаб. Практикум. –М.: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019 – 119 с.
Значимые публикации	1. Наумова А.А., Лебедев А.А., Жалнин Б.В., Слыщенко Е.В., Вагапова Н.Т. Влияние соотношения In / Ga в газовой фазе на характеристики эпитаксиальных слоев InXGa1-XP каскадных солнечных элементов / Сибирский журнал науки и технологий. – Красноярск, Т 19, № 1, 2018 – С. 137–145. 2. Генали М.А., Шаров С.К., Лебедев А.А., Вагапова Н.Т., Жалнин Б.В. Исследование просветляющего покрытия Ta ₂ O ₅ / SiO ₂ современных солнечных элементов космического назначения / Сибирский журнал науки и технологий. – Красноярск, Т 19, № 1, 2018 – С. 59–65. 3. Слыщенко Е.В., Наумова А.А., Лебедев А.А., Генали М.А., Вагапова Н.Т., Жалнин Б.В. Обзор современных фотоэлектрических преобразователей космического назначения на основе соединений A ^{III} B ^V / Сибирский журнал науки и технологий. – Красноярск, Т 19, № 2, 2018 – С. 308–324. 4. Лебедев А.А., Смирнов А.А., Наумова А.А., Вагапова Н.Т., Жалнин Б.В. Получение заданных электрофизических характеристик слоев In _{0,01} Ga _{0,99} As: (Zn/Si) солнечных элементов в процессе эпитаксии из газовой фазы. / Инженерный журнал: наука и инновации, 2020, вып. 7. http://dx.doi.org/10.18698/2308-033-2020-7-2001 . 5. Наумова А.А., Лебедев А.А., Вагапова Н.Т., Каган М.Б., Синёва М.В. Особенности создания и результаты испытаний экспериментальной солнечной батареи космического назначения с каркасом сотовой конструкции из углепластика / Инженерный журнал: наука и инновации, 2020, вып. 8. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2020-8-2003 . 6. Naumova A.A., Lebedev A.A., Milovanov A.F., Statsenko A.A., Vagapova N.T., Kagan B.M. Method for determining the balance of optical and ohmic losses for

	<p>modifying the contact grid of modern solar cells based on InGaP/InGaAs/Ge heterostructures / «AIP Conference Proceedings». – 2020</p> <p>7. Naumova A.A., Lebedev A.A., Zhalnin B.V., Vagapova N.T., Kagan B.M., Smirnov A.A., Sharov S.K. Investigation $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{P}$ and $\text{In}_x\text{Al}_{1-x}\text{P}$ heterostructures for cascade solar cells / «AIP Conference Proceedings». – 2020</p>
<p>Научное руководство /Преподавание</p>	<p>Фотопреобразователь с увеличенной фотоактивной площадью: Патент РФ 2710390 С16 МПК H01L 31/0224 / А.А. Наумова, А.Ф.Милованов, А.А. Лебедев, Н.Т. Вагапова. – Бюл. № 36, 26.12.2019.– 4 с.: ил.</p> <p>Способ изготовления фотопреобразователя Патент РФ 2730050 С1 МПК H01L 31/18 / Н.Т. Вагапова, А.А. Наумова, А.А. Лебедев, Б.В. Жалнин, Е.В. Обручева, С.К. Шаров, М.А. Генали, Т.В. Николаева, С.В. Пушко, М.Б. Каган. – Бюл. № 23, 14.08.2020. – 6 с.: 8 ил.</p>
	<p>Дисциплины, читаемые на кафедре</p> <p>Магистратура:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Технология наногетероструктур; - Оборудование для производства наногетероструктурных солнечных элементов <p>Наумова А.А. «Исследования в направлении увеличения фотоактивной площади современных и перспективных солнечных элементов на основе материалов $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ космического назначения» (аспирант 2018, руководитель).</p> <p>Смирнов А.А. «Исследование характеристик твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_y\text{In}_{1-x-y}\text{P}$, выращенных методом МОСГФЭ и применяемых в каскадных солнечных элементах» (аспирант 2019, руководитель).</p> <p>Рябцева М.В. «Исследование физических аспектов снижения уровня радиационных дефектов в СЭ на основе материалов $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ при эксплуатации в условиях космоса» (аспирант 2018, соруководитель/консультант).</p> <p>Воеводкин Г.С. «Деградация солнечных элементов для концентрированного излучения в условиях ионизирующего излучения космического пространства» (аспирант 2020, со руководитель/консультант).</p> <p>Слыщенко Е.П. «Оптимизация технологии изготовления ФП на основе материала $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ в части фотолитографических процессов» 2020 (магистр, руководитель);</p> <p>Рябцев А.А. «Электрические и температурные характеристики фотоэлектрических преобразователей на основе полупроводниковых соединений A^3B^5» 2018 (магистр, руководитель)</p>